

الجزء الثاني : الكهرباء :

الوحدة 6 : التراكيب الإلكترونية - الترانزستور

Montages électroniques – Le transistor

1. تعرف الترانزستور



اكتشف الترانزستور سنة 1948 من طرف علماء من الولايات المتحدة (Bradeen - Shockly - Brattain). وهو مركبة كهربائية لها ثلاثة أقطاب، وقد عرفت هذه المركبة من خلال توظيفها في أحزمة الاستقبال الإذاعي، والتي سميت آنذاك بآسمها. يعتبر هذا الاكتشاف عنصراً أساسياً في تقدم الإلكتروني.

يتكون الترانزستور من بلور شبه موصل من Si السيلسيوم و Ge الجermanيوم. يتم تنشيطه بإضافة كمية صغيرة جداً من ذرات دخيلة حيث نحصل على ثلاث مناطق مختلفة الموصلية. يعتبر الترانزستور ثلاثي القطب تخرج منه ثلاث أسلاك موصولة داخلياً بالمناطق الثلاث. وتسمى هذه المناطق بـ (الباعث - القاعدة - المجمع). ونميز بين نوعين من الترانزستور :

❖ ترانزستور من نوع NPN

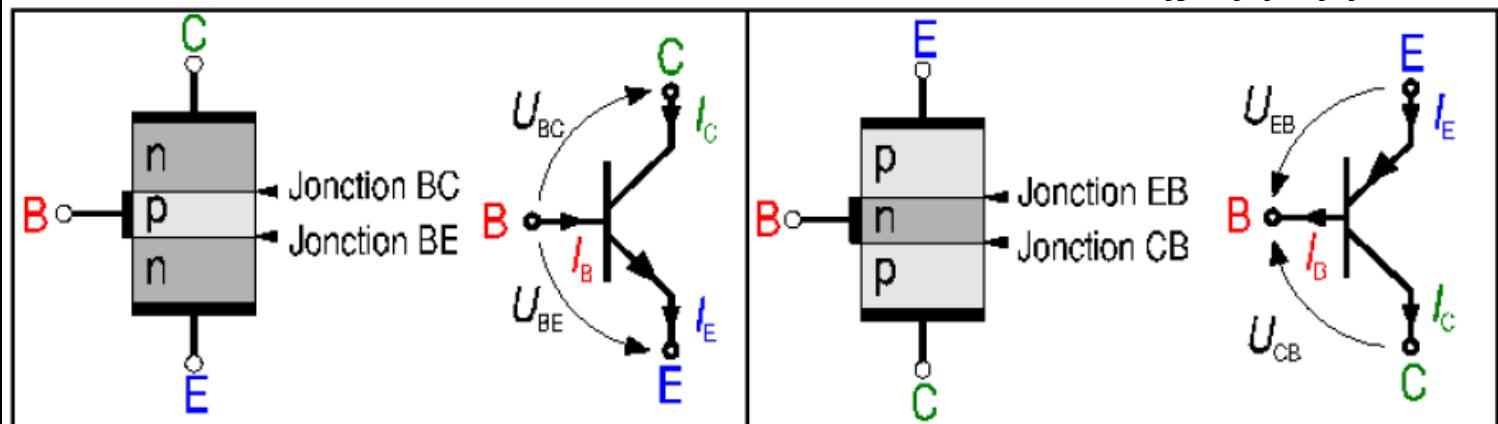
يحتوي على منطق P (من شطة من طراز P) موجودة بين منطقتين N (منشطتين من طراز N لكن بكيفية مختلفة).

❖ الترانزستور من نوع PNP

يحتوي على منطق N (من شطة من طراز N) موجودة بين منطقتين P (منشطتين من طراز P لكن بكيفية مختلفة). نسمي الوصلة، المنطقة الوسيطة التي تفصل بين منطقتين مختلفتي التنشيط؛ فالترانزستور يحتوي إذن على وصلتين مختلفتين.

يمكن التعرف على الأقطاب الثلاثة للترانزستور اعتماداً على وثائق وبطاقات تقنية، كما يمكن استعمال جهاز أوممتر لهذا الغرض.

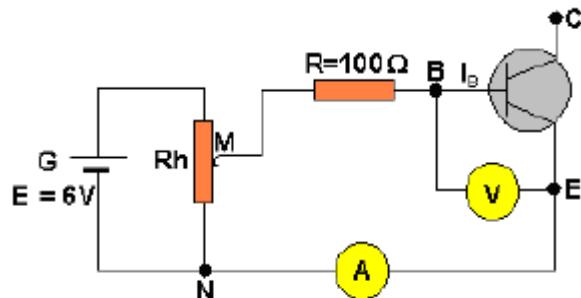
* نرمز للترانزستور بـ :



سنعتمد في باقي الدراسة، الترانزستور من نوع NPN، نظراً لشيوخه، حيث يدخل تياران كهربائيان من القاعدة والمجمعة، ويخرج تيار كهربائي من الباعث. عند تطبيق قانون العقد يمكن أن نكتب :

$$I_E = I_B + I_C$$

2. سلوك الترانزستور 2.1. استعمال "القطبين EC"



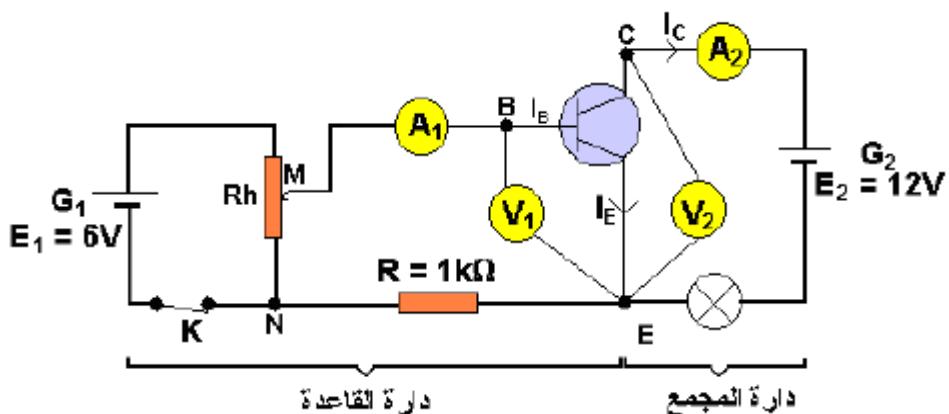
عند تطبيق توتر بين القطبين B و E لا يمر تيار كهربائي في الترانزستور إلا عندما يتجاوز التوتر بين مربطي القاعدة والباعث عتبة توتر U_{BE} . عند تمثيل المميزة ($f(U_{BE}) = I_B$) نحصل على مميزة تشبه مميزة صمام ثنائي ذي وصلة.

استنتاج :

عند استعمال الوصلة BE فقط، يتصرف الترانزستور كصمام ثنائي عادي إذ عند تركيبه في المنحى المار لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا إذا كان التوتر بين مربطيه $U_B > U_{BE}$ عتبة التوتر.

2.2. استعمال كل أقطاب الترانزستور

نستعمل الأقطاب الثلاث للترانزستور (دارة القاعدة + دارة المجمعة) وذلك بإنجاز التركيب الكهربائي التالي :



عندما نغلق قاطع التيار K ونغير التوتر U_{BE} مع إبقاء التوتر U_{CE} ثابتاً ($U_{CE} = 4,5V$) نحصل على النتائج المدونة في الجدول الآتي :

$U_{BE} (V)$	0	0,2	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75	0,78	0,80	0,81	0,83	0,84
$I_B (mA)$	0	0	0	0	0,2	0,4	0,8	1,2	2	3	5	7,2
$I_C (mA)$	0	0	0	0	30	60	120	180	198	202	204	204
أنظمة الاستعمال	الترانزستور متوقف										الترانزستور مشنع	

عموماً عند تغيير التوتر U_{BE} يمر الترانزستور من ثلاثة أنظمة :

حالة التوقف :

عندما يكون قاطع التيار K مفتوحاً، $I_C = 0$ ، ويكون الترانزستور في هذه الحالة مكافئاً لقاطع تيار مفتوح بين المجمع C والباعث E.

حالة الإشتغال الخططي :

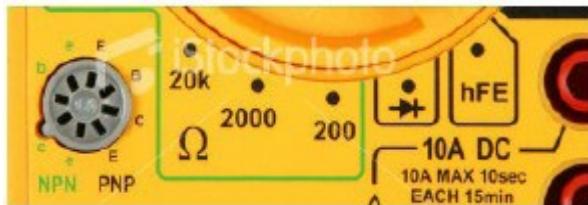
عندما يكون $U_{BE} < U_s$ ، في هذا المجال نلاحظ أن I_C تتناسب اطراداً مع I_B بحيث :

$$I_C = \beta I_B$$

β : تسمى معامل التضخيم للترانزستور، غالباً ما تكون محصورة بين 0 - 1000.

دارة القاعدة تحكم في دارة المجمع، تسمى بظاهرة مفعول الترانزستور.

يمكن قياس β بواسطة جهاز Transistometer أو جهاز متعدد القياس (نقيس المعامل β أو h_{FE}).



حالة الإشباع :

عندما تصبح شدة التيار I_C ثابتة حتى بالنسبة لقيم تزايدية لـ I_B نقول أن الترانزستور أصبح مشبعاً. يكون في هذه الحالة التوتر بين المجمع و الباعث منعدما ويصبح الترانزستور مكافئاً لقاطع تيار مغلق بين المجمع C و الباعث E.

مشبع	مضخم	متوقف	أنظمة الإشتغال
مباشر	مباشر	معاكس	استقطاب EB
مباشر	مباشر	معاكس	استقطاب CB
$I_C < \beta I_B$	$I_C = \beta I_B$	$I_B = 0$	النتائج
$U_{CE} = 0V$	$U_{CE} > 0$	$I_C = 0$	
$U_{CE} < U_{BE}$	$U_{CE} > U_{BE}$	$U_{CE} = E_2$	

ملحوظة :

يمكن للترانزستور أن يمر بسرعة من الحالة المتوقفة إلى حالة الإشباع أو العكس صحيح دون المرور بالإشتغال الخططي، نقول أن الترانزستور يشتغل بالكل أو لا شيء.

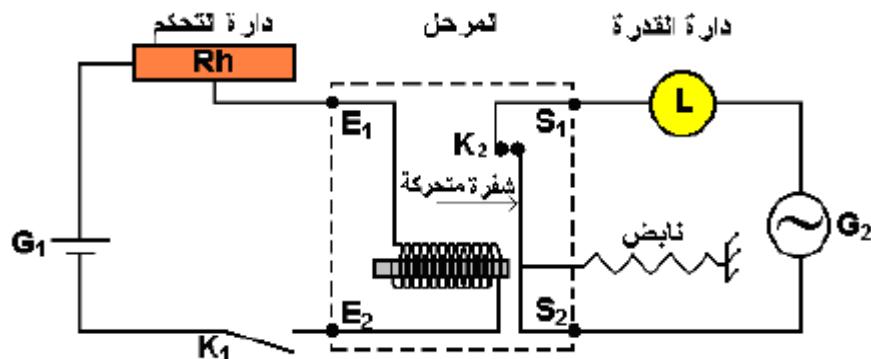
4. بعض التراكيب الالكترونية البسيطة التي تحتوى على الترانزستور

1. المرحل : Relais



الم رحل رباعي القطب يتكون من سادس ا من كهرومغناطيس قادر على فتح أو غلق قاطع التيار حسب قيمة توتر دارة التحكم للمرحل.

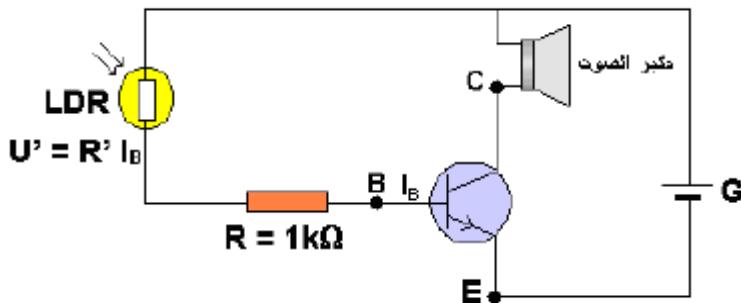
❖ مبدأ اشتغال المرحل



عند غلق قاطع التيار K_1 تجذب نواة الكهرومغناطيس مما يؤدي إلى غلق قاطع التيار K_2 (الشفرة المتحركة). وبالتالي يضيء المصباح.

عند فتح قاطع التيار K_1 ترجع الشفرة إلى موضعها الأول (بواسطة تأثير المagnet) في فتح قاطع التيار K_2 فينطفئ المصباح.

2. تركيب مؤشر الصوّة

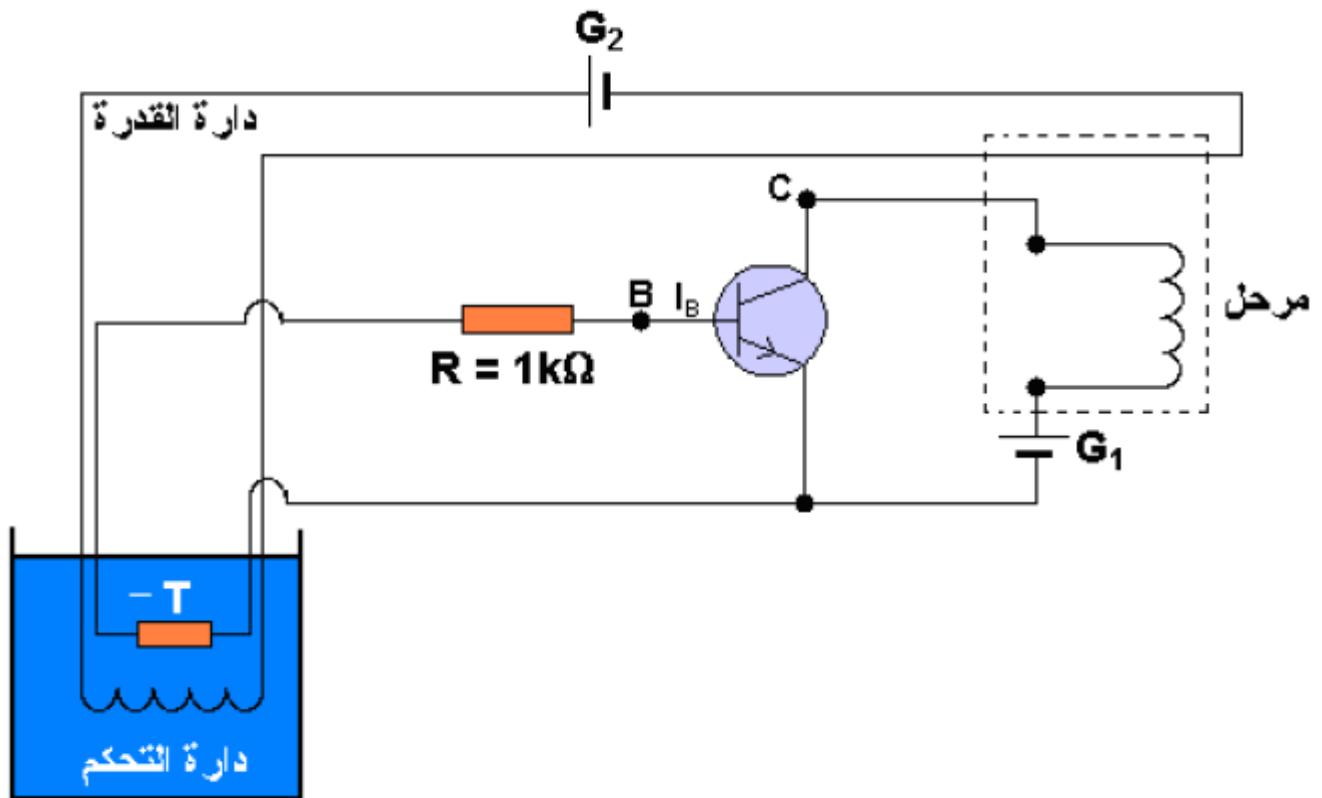


هذا التركيب يمكن من التحكم في مكبر الصوت بواسطة إضاءة المقاومة الضوئية L.D.R، في الضوء يصدر مكبر الصوت صوتا معينا و في الظلام لا يصدر أي صوت.

تعليق : في الضلام تكون مقاومة L.D.R هي $R' = 1M\Omega$ و هي قيمة صغيرة جدا يمكن اعتبارها منعدمة. وبالتالي $I_C \approx 0$, إذن لا يمر أي تيار في مكبر الصوت.

في الضوء تكون كذلك مقاومة L.D.R هي $R' = 100\Omega$ ومنه تكون $I_B = 100\Omega$ قيمة مهمة، وبالتالي تكون كذلك I_C قيمة مهمة تمكن من تشغيل مكبر الصوت.

3. مؤشر السخونة



يمكن هذا التركيب من التحكم في المرحل بواسطة المقاومة الحرارية CTN.

عند درجة حرارة منخفضة لـ CTN لن تشتعل دارة القدرة.

عند درجة حرارة مهمة لـ CTN تشتعل دارة القدرة.

تعليق :

عند درجة حرارة منخفضة تكون لـ CTN مقاومة جد كبيرة وبالتالي تكون $I_B = 0$ إذن $I_C = 0$ يقفل المرحل ولا تشتعل دارة القدرة.

عند درجة حرارة مرتفعة تكون لـ CTN مقاومة ضعيفة وبالتالي يمر تيار I_B , إذن يمر تيار I_E , يغلق المرحل وتشتعل دارة القدرة.